

سولیتون، پلارون و بی پلیمرهای رسانا

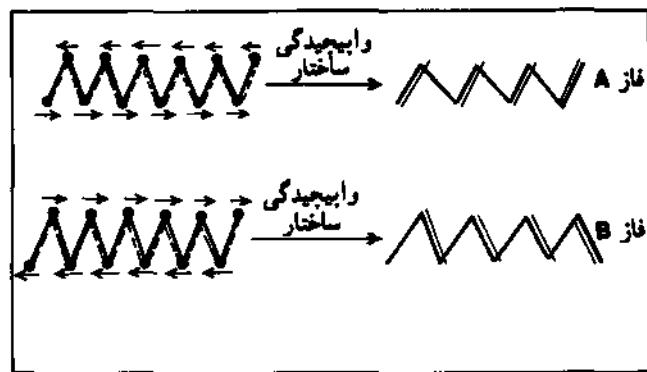
Soliton, Polaron, Bipolaron in Conducting Polymers

بهرزاد پور عباس، علی اکبر انتظامی
دانشگاه تبریز - دانشکده شیمی - آزمایشگاه برونهای

واژه‌های کلیدی:
برانگیختنگی، سولیتون، پلارون، بی‌پلارون، پلیمرهای رسانا

یکسانی داشتند (کوتاهتر از پیوند ساده و بلندتر از پیوند دوگانه)، آن‌گاه پلیمر می‌توانست مانند یک فاز رسانایی الکترونیکی بالا داشته باشد، ولی وضعیت الکترونها « و طول پیوندها به این صورت نیست.

پیرلز (Peterls) در سال ۱۹۵۵ مطرح کرد که در چنین ساختارهایی شبه تک بعدی معمولاً یک واپیجیدگی^{*} (distortion) ساختاری از اتمهای زنجیر به چشم می‌خورد [۱]. در نتیجه، هر اتم کربن به اتم کربن همسایه نزدیکتر شده و همزمان از همسایه دیگر دورتر می‌شود. از این‌رو، یکسانی طول پیوندها از بین می‌برد و پیوندهای کوتاه و بلند یک در میان (مزدوج) به وجود می‌آید که پیوندهای کوتاهتر پیوندهای دوگانه و پیوندهای بلندتر پیوندهای ساده را تشکیل می‌دهد (شکل ۱).



شکل ۱ - واپیجیدگی ساختاری و ایجاد پیوندهای یک در میان و مستقر.

در اثر این واپیجیدگی انرژی ترازهای « کاهش باتفاق و از سوی دیگر، انرژی کشناسی پلیمر افزایش می‌یابد. رقابت بین این دو عامل باعث می‌شود که طول پیوند به یک حد تعادلی برسد، که مثلاً برای بولی استیلن $\text{Å} = 0.103 - 0.104$ است.

مستقر شدن الکترونها « و به وجود آمدن پیوندهای کوتاه و بلند

* اعراج

چکیده
پلیمرهای رسانا پلیمرهای هستند که در ساختار زنجیرهای تک بعدی انسجام می‌شوند و وجود دارد معمولاً، واپیجیدگی ساختار باعث می‌شود که پلیمرها با روشهای مختلف در به کار رفته باشند. این پلیمرهای رسانا می‌توان به (سولیتون، پلارون و بی‌پلارون) در زنجیرهای انسامن برانگیختگیهای مختلف برانگیختنگیها و روشهای فناوری‌ای اثناه مورد به عنوان مثال آثار این پلیمرها بر این مدت قرار می‌گیرد. از آنها که اغلب این پروسهای تروط فیزیک‌دانها به انجام رسیده، معنی دارد است تا در حد امکان از مفاهیم پیچیده فیزیکی پرهیز شود و تنها تابع به دست آمده مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه
از آنجا که پلیمرها به طور نوعی عایق‌اند، اندیشه وجود پلیمرهای رسانا به دشواری مورد قبول واقع شد. این مطلب در مورد پلیمرهای کووالانسی صادق است، یعنی پلیمرهایی که در آنها هر چهار الکtron و الکس کربن در پیوندهای کووالانسی درگیر است. ولی در پلیمرهایی که آرایش مزدوج دارند، وجود رسانایی الکترونیکی چندان هم دور از واقعیت نیست. در پلیمرهای با آرایش مزدوج اتمهای کربن دارای هیبرید شدگی SP^2P می‌باشند. هیبرید شدن P را می‌توان هیبرید شدن کربن SP^2 همراه با، یک اوربیتال P جهت تشکیل پیوندهای « در نظر گرفت. بدین ترتیب، یک الکترون نایپوندی در اوربیتال P وجود دارد که سیستم « مزدوج را در پلیمر به وجود می‌آورد.

در پلی استیلن، به عنوان مثال، این سیستم « مزدوج که از الکترونها نایپوندی به وجود می‌آید، نیمی‌می‌است. در شبکه پلیمر، پیوندهای درون زنجیری قوی و برهم کنشهای بین زنجیری ضعیف است. به عبارت دیگر، الکترونها « تنها در طول زنجیر پلیمر نامستقر (delocalised) بوده و از این روست که از نظر الکترونی « شبه تک بعدی (quasi-one dimensional)» می‌باشند.

اگر در ساختار زنجیرهای پلیمر، الکترونها « می‌توانند آزادانه در تمام طول زنجیر حرکت کنند، یا به عبارتی تمام پیوندها طول

Key Words: excitation, soliton, polaron, bipolaron, conducting polymers

باعث می شود که بین نوار رسانش و نوار والانس یک شکاف انرژی (energy gap) به وجود آید (شکل ۲).

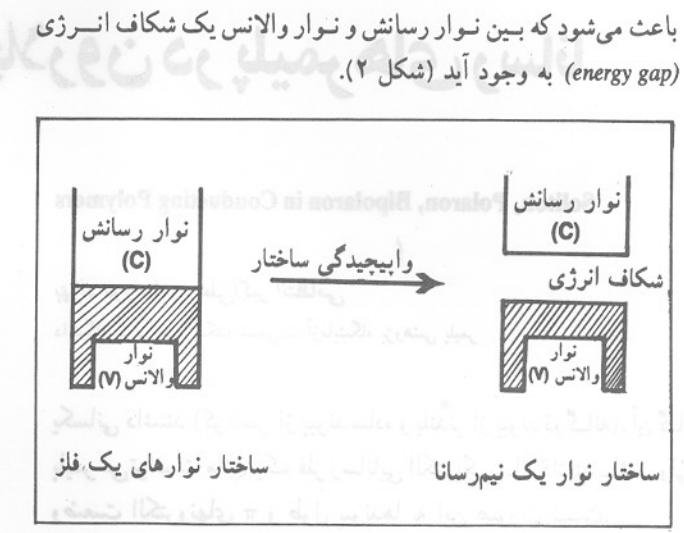
بسیار کم، یعنی در حدود جرم الکترون و نه در حدود جرم یون باشد. بدین ترتیب، این دیواره در حقیقت یک ذره کوانتو می است [3] که درباره آن توضیح کاملتری خواهد آمد.

با توجه به این واقعیت که دیواره یاد شده یک برانگیختگی غیرخطی و حفظ کننده شکل است و در ضمن آزادانه حرکت می کند، می توان آن را یک «سولیتون» (soliton) نامید [4]. این اصطلاح کاملاً هم اختصاصی نیست، زیرا فرض بر این است که سولیتونها از روی یکدیگر عبور می کنند، ولی در عین حال شکل یکدیگر را حفظ می کنند. این عمل به طور مسلم در برانگیختگیهای دیواره ای صدق نمی کند. با وجود این، ماهیت ذره مانند (particle like) این دیواره ها غالباً بوده و سولیتون یک اصطلاح استاندارد شده است.

از آنجا که سولیتونها خاصیت توپولوژیک دارند و یک سولیتون متحرک فاز A را به فاز B (و بر عکس) تبدیل می کند، سولیتونها تنها می توانند به صورت یک جفت به وجود آیند یا از بین بروند. به عبارت دیگر، اگر یک سولیتون فاز A را به B تبدیل کند سولیتون دوم دوباره فاز B را به A تبدیل می کند. از این رو، سولیتون دوم را ضد سولیتون می نامند.

چون سولیتون اثر قابل توجهی بر الگوی پالیمر می گذارد، به طور مقابله اثر ویژه ای بر طیف الکترونی پالیمر دارد. با توجه به کارهای انجام شده در زمینه شیمی کوانتمو [2] معلوم شده است که در اثر به وجود آمدن سولیتون، یک تراز الکترونی در نزدیکی مرکز شکاف انرژی به وجود می آید. این تراز در سولیتون خنثی با یک الکترون اشغال می شود. چون یک الکترون منفرد دارای اسپین $\frac{1}{2}$ است و بقیه ترازهای موجود در سیستم همگی اسپین جفت شده دارند، بنابراین سولیتون خنثی دارای اسپین $\frac{1}{2}$ می باشد. به عبارت دیگر، این ذره همانند یک رادیکال آزاد خنثی است با این ویژگی که در منطقه ای به وسعت 14a گسترده شده است. از نظر فیزیکی این برانگیختگی در واقع یک حالت خاص است، زیرا این تراز در شکاف انرژی یک پاسخ معادله شرودینگر است و می تواند توسط 1a یا 2a الکترون اشغال شود. یک سولیتون باردار که 0a دارد این تراز در تراز شکاف انرژی دارد به جای اینکه دارای اسپین $\frac{1}{2}$ باشد، بار $\pm\text{e}$ و اسپین صفر دارد. این رابطه معکوس بین اسپین و باریک ویژگی اساسی برای سولیتونهاست که نتایج تجربی نیز آن را تأیید می کند [5].

در پالیمرهای رسانا می توان با استفاده از روشهای مختلف سولیتونها را با چگالیهای دلخواه به شبکه پالیمر تزریق کرد. این عمل را دوپه کردن (doping) پالیمر می گویند. دوپه کردن می تواند به روشهای شیمیایی، الکتروشیمیایی و نورشیمیایی انجام گیرد. از این رو، می توان برای مطالعه سولیتونها آنها را به میزان دلخواه، در زنجیرهای پالیمری به وجود آورد. در این مقاله نتایج تجربی و نظری موجود برای سولیتونها در پلی استیلن و پلی تیوفن مورد بررسی قرار خواهد گرفت که نتایج به دست آمده را می توان به سایر سیستمهای پالیمرهای رسانا نیز تعمیم داد.



شکل ۲ – اثر وابیجیدگی ساختار بر ساختار نوار.

در اثر ایجاد این شکاف انرژی، پلی استیلن برخلاف انتظار یک نیمرسانا می شود و دیگر نمی تواند همانند یک فلز باشد. اگر در زنجیر پالیمر اتمها (یا مونومرها) را با شماره های $1, 2, 3, \dots$ مشخص کنیم، می توانیم پیوندهای π را به دو صورت مختلف در زنجیر قرار دهیم، یعنی: $6 - 5 = 4 - 6 = 1 - 2 = 3 - 4 = 5 - 6 = 2 - 3 = 4$. این دو ساختار پیوندی را به تراز فاز A و فاز B می نامند (شکل ۱). روشن است که اگر مونومرها یکسان و طول زنجیر بی نهایت باشد، انرژی این ساختارهای پیوندی یکسان خواهد بود. به عبارت دیگر، در حالت پایه (ground state) دو تراز با انرژی یکسان وجود خواهد داشت.

در اوایل سال ۱۹۶۰ معلوم شد که در این نیمرساناهای، به علاوه برانگیختگی (excitation) الکترون – حفره، نوع جدیدی از برانگیختگی نیز وجود دارد. این برانگیختگی همانند دیواره ای است که منطقه مربوط به هر یک از فازهای A و B را در زنجیر پالیمر از هم جدا می کند. این برانگیختگی تازه «بی قوارگی» (misfit) نامیده شده است [2]. در ابتدا هیچ تحلیلی مبنی بر ضخامت این بی قوارگی ارائه نشد، ولی چنین استدلال می کردند که ضخامت این دیواره به حدود چند اتم می رسد [2]. بعد از آن مشخص شد که ضخامت واقعی این برانگیختگی در حدود 14a می باشد که تصویر دو اتم کربن مجاور در امتداد زنجیر پالیمر است [3].

بزرگ بودن ضخامت این دیواره منجر به آثار کیفی مهمی می شود:

- (۱) تغییر انرژی شبکه در اثر حرکت مرکز این دیواره بسیار کم خواهد بود، یعنی این دیواره (جزء دماهای خیلی پایین) در موادی که قادر نقص ساختاری باشند برای حرکت کاملاً آزاد است. این حرکت در بی قوارگیهایی که ضخامتی در حد 14a دارند ممکن نیست، زیرا در این صورت برانگیختگی باید برای عبور از محلی به محل دیگر از یک سد بزرگ انرژی عبور کند یا به عبارتی این برانگیختگیها نامتحرک می باشند.
- (۲) ضخامت بزرگ دیواره سبب می شود که جرم مؤثر این دیواره

دویه کردن پلیمرها

پلی استیلن را می توان پس از سنتز با تعدادی از دویه کننده ها در دمای اتاق دویه کرد که رشته خاصی را در زینه پلیمر های رسانا تشکیل می دهد [6]. امروزه عمل دویه کردن برای بسیاری از سیستمهای پلیمری به کار گرفته می شود [7]. به طور کلی پلیمر های که سیستم Π مزدوج دارند، می توانند به طور برگشت پذیر و در دمای اطاق دویه شوند. اصطلاح «دویه کردن» متراff «اکسایش» یا «کاهش» است و دویه کردن پلیمر سبب می شود که:

الف – انتقال بار (توسط اکسایش یا دویه کردن نوع p و کاهش یا دویه کردن نوع n) صورت گیرد.

ب – یک بار مخالف به درون شبکه پلیمر (جهت خنثی شدن بار الکترونی) نفوذ کند.

ج – بتوان به طور همزمان با اعمال دویه کردن، «ترازفرمی»^{*} (Fermi level) یا پتانسیل شیمیایی^{**} (E_F) را کنترل کرد.

با استفاده از عمل دویه کردن می توان خواص سوری و الکترونی پلیمر های رسانا را از حد یک عایق تا یک فلز تغییر داد.

دو خاصیت ساختاری مهم در پلیمر وجود دارد که عمل دویه کردن پلیمر را آسان می سازد: ۱) فضای شکل شناختی (morphologic) زیاد و نیروهای بین زنجیری ضعیف، نفوذ یون دویه کننده را به میان زنجیرهای پلیمر ممکن می سازد. به عنوان مثال قطر شکل شناختی الیاف پلی استیلن «شیراکاوا (Shirakawa)» که حدود 200 \AA است، اشاره بر این دارد که مولکول دویه کننده به مسافتی کمتر از 100 \AA نیاز دارد تا به زنجیر پلیمر برسد (در نتیجه عمل دویه کردن از لحاظ سینتیکی سریع خواهد بود). ۲) به دلیل قوی بودن بینهای زنجیری، پلیمر در حین فرایند نفوذ دویه کننده تغییر شکل نسی دهد و از این رو، عمل دویه کردن یک عمل برگشت پذیر خواهد بود. برگشت دادن فرایند دویه کردن یا به اصطلاح نادویه کردن (undoping) را می توان با اندازه گیری ضریب جذب کنترل کرد [8]. نتایجی که از پلی استیلن دویه شده نوع n و p در این مورد به دست آمده است، مشابه هم می باشند. بدین ترتیب که پس از خنثی سازی شیمیایی [9] یا الکتروشیمیایی [8] نوئمهای دویه شده نوع n یا p ، دوباره طیف مربوط به ترانس – $(CH)_2$ دویه نشده را نشان می دهند.

پلی استیلن، ساده ترین پلیمر مزدوج

پلی استیلن یک پلیمر خطی است که در آن زنجیرهای $(CH)_2$ با نیروی ضعیفی به هم ارتباط دارند که بدین ترتیب یک شبکه «شبیه یک بعدی» را به وجود می آورند. زاویه ایدهآل 120° بین این سه یون (هیرید شدن P) با دو آرایش مختلف ترانس – $(CH)_2$ و سیس – $(CH)_2$ ممکن می شود که هر یک به ترتیب دارای ۲ و ۴ مونومر $-CH_2-$ در واحد تکرار شونده می باشند (شکلهای ۳ – الف و ب). در هر یک از این ایزومرها الکترون از آن تمام سطح ارزی خالی است.

* پتانسیل شیمیایی مشابه ترازفرمی تعریف می شود و با افزایش برانگیختگیها در پلیمر، سطح آن ارتقا پیدا می کند.

حاملینی که به علت دویه کردن در $(CH)_2$ به وجود می آیند، در اثر فرایند انتقال بار تولید می شوند [10]. اگر انتقال بار از پلیمر به یک پذیرنده (A) صورت گیرد، می این عمل زنجیر پلیمر مانند یک پلی (کاتیون) در حضور گونه های A عمل می کند و در برآبردهنده ها (D)، زنجیر پلیمر نفس یک پلی (آنیون) را به عهده می گیرد و در ضمن یونهای مخالف D یا A در بین زنجیرهای پلیمر باقی می مانند. دویه کردن را می توان با قرار دادن پلیمر در بخار یک الکترون پذیر (نظیر یدیامنی A₆F₅) یا یک الکترون ده (نظیر یک فلز قلبی) انجام داد[†] در فاز محلول و با انتقال بار شیمیایی یا با اکسایش و کاهش الکتروشیمیایی عملی کرد. البته، روش دویه کردن در فاز محلول آسانتر است.

پلی استیلن سیس و ترانس نسخین بار توسط شیراکاوا و همکارانش تهیه شد [13]. این پلیمر را می‌توان به صورت فیلمی نازک روی برخی مواد پایه، نظری شیشه و فلز، با ضخامتی بین $10\text{--}100\text{ }\mu\text{m}$ تهیه کرد. ایزومر ترانس- CH_2 از لحاظ ترمودینامیکی بایدارتر است و نسبت بین ایزومرهای سیس و ترانس را می‌توان در دماهای بایین حفظ کرد ولی در دماهای بیش از 150°C در مدت چند دقیقه ایزومر شدن کامل سیس به ترانس اتفاق می‌افتد.

بررسیهای شیراکاوا با میکروسکوپ الکترونی روی فیلم در حال رشد پلی استیلن [13] نشان می‌دهد که زنجیرهای CH_2 از الیاف بی‌نظم، عموماً با قطری حدود $4\text{ }\text{\AA}$ ، تشکیل می‌شوند. برای افزایش نظم الیاف پلیمر می‌توان نمونه پلیمر را در جهت زنجیرها مورد کشش قرار داد. در اثر این عمل طول نمونه تا $3\text{ }\mu\text{m}$ افزایش می‌یابد و چگالی آن از $1/28\text{ cm}^3$ به $1/2\text{ g/cm}^3$ می‌رسد.

روشهای گوناگونی برای تهیه پلی استیلن به کار گرفته شده است که در این میان روش مورد استفاده در دانشگاه دورهام (*Durham*) دارای مزیتها و نیزهای است [6]. در روش تهیه دورهام از پیش پلیمرهای استفاده می‌شود که در نهایت به پلی استیلن تبدیل می‌گردند. پلی استیلن دورهام را می‌توان در شکل بی‌ریخت (آمورف) آن، یعنی در هنگام رشد، مورد مطالعه قرار داد. همچنین می‌توان آن را به صورت فیلمهای مستقل و ناهمسان (*anisotropic*) تهیه کرد. شکل شناسی پلی استیلن دورهام با پلی استیلن «شیراکاوا» متفاوت است، به حدی که پلی استیلن دورهام دارای آن چنان چگالی بالایی است که با میکروسکوپ الکترونی نمی‌توان ساختار الیاف آن را تشخیص داد.

وجود پیوندهای دوگانه مزدوج گرچه مسئله مهمی در شیمی کوانتومی به حساب می‌آمد، ولی امروزه با استفاده از مطالعات مستقیم شواهدی دال بر وجود این پیوندهای مزدوج ارائه شده است.

همچنین با تحلیل پر اش اشعه ایکس ساختار بلوری ترانس- CH_2 مشخص شده است (شکل ۴) گروه فضایی آن از نوع P_{111}^1 است و دو زنجیر در هر واحد ساختاری وجود دارد.

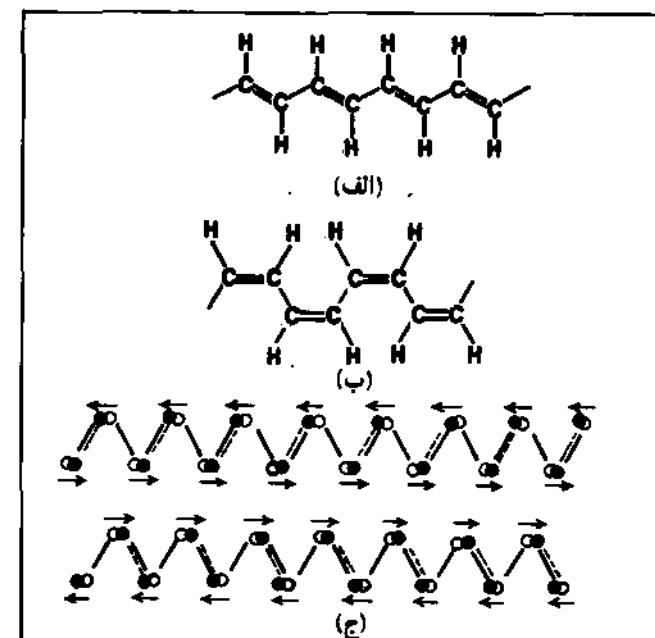
فاصله بین ابتدای نوار والانسی و انتهای نوار رسانش، W ، در پلی استیلن حدود 12 \AA الکترون ولت است و به دلیل وجود تناوب پیوندها در پیکره پلیمر، ترانس- CH_2 (یک نیمه رسانای به شدت ناهمسان با شکاف انرژی $E_g = 1.7\text{ eV}$ در حدود 1.8 eV می‌باشد).

سولیتونها در ترانس- CH_2

براساس محاسبهای انجام شده انرژی تولید سولیتون (E) از لحاظ نظری حدود $7.0\text{--}7.4\text{ eV}$ است، یعنی کمتر از نصف شکاف انرژی (ΔE) می‌باشد، چون $7.0 = 1/8\text{ }E_{\text{g}}$ است. از آنجا که سطح پتانسیل شیمیابی مواد دویه نشده در وسط شکاف انرژی قرار دارد، این نتایج نظری نشان می‌دهد که سولیتونها با انرژی کمتری نسبت به یک الکترون - حفره تولید می‌شوند. به همین دلیل وقتی الکترون یا حفره در اثر دویه

والانس باقیمانده در اوربیتال $2P_3/2$ قرار می‌گیرد که این اوربیتال عمود بر صفحه‌ای است که از سه پیوند دیگر ایجاد می‌شود. از نظر انرژی پیوندی پیوندهای π پیوندهایی با انرژی کم و کاملاً پر می‌باشند، در حالی که پیوندهای π نیمه پرند و نوار انرژی ویژه‌ای را به وجود می‌آورند که علت خاصیت الکترونی مهم این پلیمر می‌باشد.

اگر تمام پیوندها طول یکسانی داشتند، ترانس- CH_2 خالص می‌توانست، یک شبکه فلز تک بعدی، $1D$ -*Dimensional*، با نوار نیمه بر به شمار آید. ولی چنین سیستمی با توجه به «وابسیجیدگی ساختاری» ناپایدار است، به طوری که ناپایداری پیراز و حرکت CH_2 ‌های مجاور به سمت یکدیگر باعث می‌شود که پیوندهای کوتاهتر (دوگانه) و بلندتر (ساده) متواتری در زنجیر به وجود آید [1,2] و در نتیجه انرژی سیستم پایین رود (شکل ۳-ج). روش است که پیوندهای دوگانه و ساده می‌توانند با هم جایه‌جاشوند، بدون اینکه انرژی سیستم تغییر یابد. بدین ترتیب، در حالت پایه دو تراز با انرژی یکسان، هم ترازی (*degeneracy*)، وجود دارد که در واقع همان فازهای A و B است که ساختارهای پیوندی مختلف ولی انرژی یکسانی دارند. این هم ترازی منجر به یک حالت برانگیختنگی توبولوزیک غیرخطی [3] یا به عبارتی دیواره‌هایی می‌شود که فازهای مختلف در زنجیر را از هم جدا می‌کند. این دیواره‌ها را سولیتون می‌نامند که می‌تواند علت خواص مشاهده شده در ترانس- CH_2 باشد. در سیس- CH_2 تقارن به حدی نیست که دو حالت پیوندی مختلف زنجیر انرژی یکسانی داشته باشند. در نتیجه در حالت پایه آن، دو ایزومر پیوندی مختلف با سطح انرژی متفاوت وجود خواهد داشت.



شکل ۳ - شکلهای ساختاری پلی استیلن: (الف) سیس- CH_2 ، (ب) ترانس- CH_2 و (ج) در حالت پایه هم انرژی در ترانس- CH_2 [18].

* نفتالید Naphthalide

سولیتونهای خنثی (S^z) که اسپین $\frac{1}{2}$ دارند، مشابه رادیکالهای آزاد و سولیتونهای باردار (S^z) نیز مشابه یونهای بدون اسپین می‌باشند. با وجود این، اگر از حرکت سولیتونها جلوگیری نشود درست بر عکس مشابههای شیمیایی خود به آزادی حرکت می‌کنند. از نقطه نظر فیزیکی نیز درواقع چنین است که یک رابطه معکوس بین اسپین و بار در سولیتونها وجود دارد و این رابطه بر عکس رابطه‌ای است که برای حفره و الکترون موجود است. به عبارت دیگر، یک سولیتون باردار (S^z) فاقد اسپین است در حالی که الکترونها و حفره‌ها اسپین $\frac{1}{2}$ دارند.

ویژگی دیگر سولیتون جرم جنبشی آن (m_e) است. جرم جنبشی سولیتون براساس محاسبات انجام شده نسبت عکس با بهنای سولیتون (ϵ) دارد و با توجه به اینکه در مورد بهنای سولیتون رابطه: $145 \approx 24$ برقرار است، خواهیم داشت:

$$\mu = 6 m_e$$

که جرم الکترون است. کوچکی μ بیان می‌کند که در اثر عبور سولیتون، هسته انرژی جنبشی اندکی به خود می‌گیرد و همچنین اشاره براین دارد که سولیتونها در واقع ذرات کوانتومی می‌باشند.

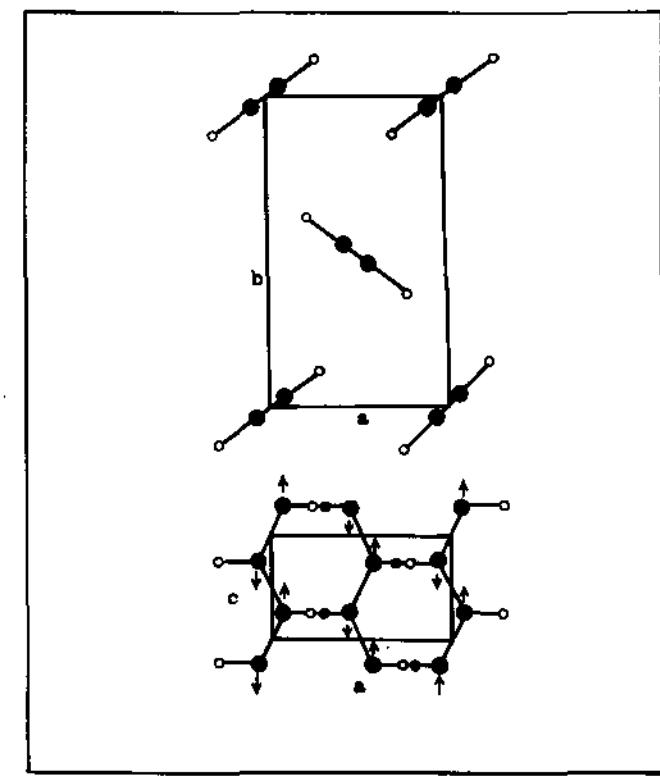
خلاصه‌ای از تبعیج تجزیی

مطالعات تجزیی روی سولیتونهای خنثی در ترانس- $_{\text{C}}(\text{CH})$: سولیتونهای خنثی در اثر ایزومر شدن (از سیس به ترانس) به وجود می‌آیند. اسپین جفت شده سولیتون خنثی امکان انجام مطالعات رزونانس مغناطیسی را فراهم می‌سازد که با استفاده از تبعیج به دست آمده می‌توان برخی خواص مهم از قبیل مغناطیسی پذیری (*magnetic susceptibility*) و بستگی آن به دما و گسترش فضایی تابع موج را تعیین کرد.

این گونهای با اسپین $\frac{1}{2}$ در مرحله تختست به عنوان نقصی در گسترش الکترونها μ می‌باشند که به طور تقریب یکی به ازای هر 3000 اتم کربن در زنجیر ترانس $\frac{1}{2}(\text{CH})$ وجود دارد [14].

برای تعیین اینکه گونهای با اسپین $\frac{1}{2}$ از لحاظ الکتریکی خنثی می‌باشند یا باردار، چندین آزمایش انجام شده است. اگر پلیمر با آمونیاک خنثی شود تعداد کل اسپینها تغییر نمی‌کند، ولی رسانایی الکتریکی به مقدار زیادی افت پیدا می‌کند که می‌تواند در اثر کاهش تعداد حاملین بار یا کاهش تحرک آنها باشد. از آنجا که مشخص شده است تحرک حاملین بار تغییر نمی‌کند، از این رو تعداد حاملین بار کاهش یافته است. ولی، چون تعداد اسپینها ثابت مانده است، نتیجه گیری می‌شود که بار و اسپین مستقل از یکدیگرند.

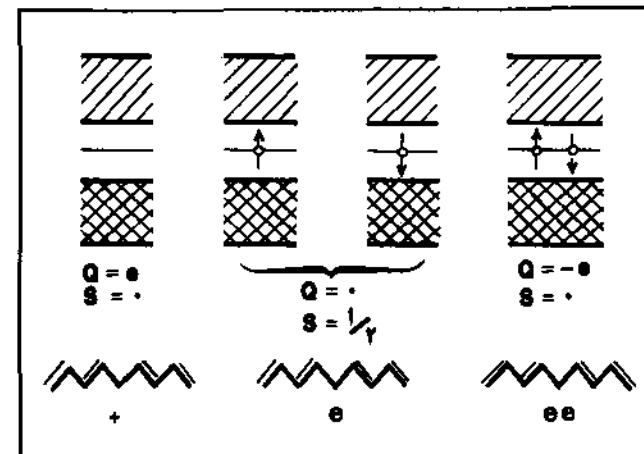
از سوی دیگر، در طیف IR نمونهای دارای مقادیر حداقل 0.03 درصد مولی از نقصهای باردار یک پیک در 1370 cm^{-1} وجود دارد، ولی چنین یکی برای نمونهای دارای گونهای با اسپین $\frac{1}{2}$ دیده نمی‌شود. بدین ترتیب، این نمونهای فاقد نقصهای بار دارند. در نتیجه، سولیتونهای خنثی دارای اسپین $\frac{1}{2}$ و بار صفرند.



شکل ۴ - دو تصویر نمایشی از ساختار ترانس- $_{\text{C}}(\text{CH})$. در این تصویر $c = 4/22 \text{ \AA}$ ، $a = 7/32 \text{ \AA}$ ، $b = 7/37 \text{ \AA}$ و بیکانهای نشان دهنده جهت جایه‌جایی اتمها به هنگام ایجاد پیوندهای مزدوج است [12].

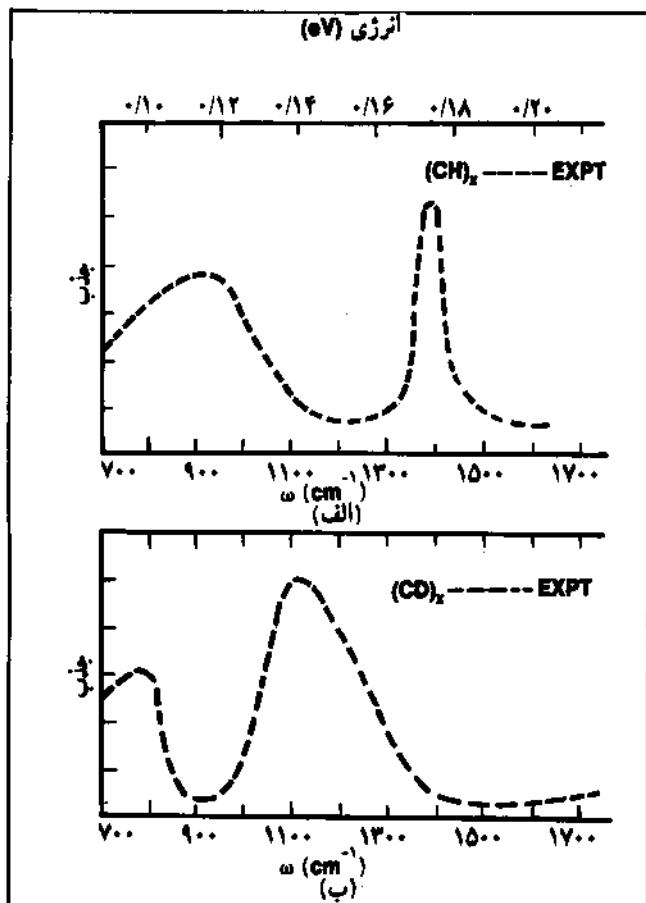
کردن به روش نوری یا گرمایی نمونه تزریق می‌شود، سولیتونها خود به خود به وجود می‌آیند.

سولیتونها در مرکز شکاف انرژی یک تراز انرژی دارند که می‌تواند توسط 100 یا 2 الکtron اشغال شود. این تراز انرژی و نمایشی از پیوندهای شیمیایی مستقر در شکل ۵ نشان داده شده‌اند.



شکل ۵ - ساختارهای الکترونی که متبر به ایجاد بار (Q) های مختلف و اسپین (S) در یک سولیتون می‌شود [18].

سولیتونها در ترانس - ν : دوبه گردن با انتقال بار گونهای ارتعاشی فعال در $IRAV, IR$: گونهای ویژه $IRAV$ در نخستین بررسیهای طیف نگاری انجام شده نمونهای که به میزان کم دوبه شده بودند، به ثبت رسیده است [17]. گونهای اصلی $IRAV$ عبارت اند از: $\approx 900, 1260, 1370 \text{ cm}^{-1}$ به علاوه یک گونه ضعیف در 1215 cm^{-1} . جذبهای به وجود آمده در اثر دوبه گردن پلیمر به طور قابل ملاحظه‌ای شدیدند (که در توافق با قدرت نوسانگر پیش‌بینی شده برای دیواره‌های متعرک است) و همچنین نسبت به اثر ایزوتوپ حساسی باشند [17]. به ترتیبی که جا به جای مریبوط به تبدیل $\nu(CH)$ به $\nu(CD)$ را نشان می‌دهند. گونهای $IRAV$ به وجود آمده در اثر دوبه گردن، برای $\nu(CH)$ و $\nu(CD)$ در شکل ۷ ارائه شده است. شدت گونهای $IRAV$ متناسب با غلظت دوبه کننده است [17]. ولی فرکانسها اصولاً مستقل از گونهای دوبه کننده می‌باشند. به علاوه، جذب در امتداد استخوانینی پلیمر، قطبیده است که از بررسیهای انجام شده روی نمونهای به شدت جهت داده شده، مشخص شده است [12]. بنابراین، وجود این آثار ویژه در طیف IR به روشنی مشخص می‌کند که گونهای باردار مریبوط به واپیجیدگی ساختاری در اثر دوبه گردن پلیمر به وجود می‌آیند.



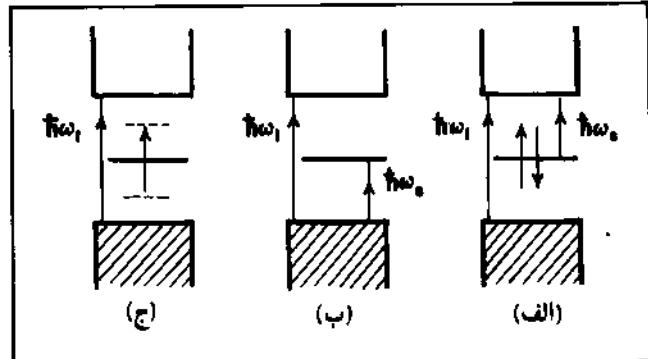
شکل ۷ - گونهای ارتعاشی فعال در IR که در اثر دوبه گردن در ترانس - پلی استیلن به وجود می‌آیند: (الف) ترانس - $\nu(CH)$ و (ب) ترانس - $\nu(CD)$ [17].

با استفاده از نتایج مطالعات رزونانس دوگانه الکترون و هسته گونهای با اسپین - به دست آمده و مشخص شده است که این گونهای دارای $\approx 7\%$ می‌باشند.

برای بررسی تحرک سولیتونهای خنثی از روش‌های ESR و قطبیسی $(Dynamic Nuclear Polarization) DNP$ ، استفاده شده است. کاهش پهنای یک ESR در اثر حرکت گونهای دارای اسپین، نشان می‌دهد که این گونهای سازگار می‌باشند. همچنین از بررسیهای DNP برداشت می‌شود که سولیتونهای خنثی در دماهای پایین غیرمتحرک و در دماهای بالا خیلی متحرک می‌باشند. بر طبق این آزمایشها، سولیتونهای خنثی بین دماهای $10\text{--}100 \text{ K}$ به تدریج از سولیتونهای ثابت به سولیتونهای متعرک تبدیل می‌شوند.

مطالعات تجزیی روی سولیتونهای باردار در ترانس - $\nu(CH)$: سه اثر ویژه به هنگام تولید سولیتونهای باردار وجود دارد که برای آنها تحلیلهای دقیق نظری و شواهد تجزیی ارائه شده است.

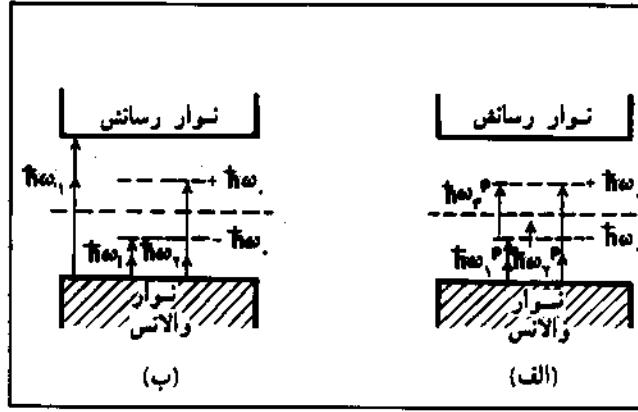
الف - ایجاد واپیجیدگی ساختاری مستقر همراه با گونهای ارتعاشی مستقر (*localized*) فعال در $IRAV, IR$ و $Infra-Red$: این گونهای ارتعاشی را می‌توان در ناحیه متوسط فرکانسها IR که مخصوص ارتعاشهای مولکولی است، مشاهده کرد. ب - به وجود آمدن یک تراز در وسط شکاف انرژی و انتقالهای الکترونی مریبوط به آن، $\Delta\nu = 7\%$ (شکل ۶). این انتقالهای را می‌توان در ناحیه IR نزدیک مشاهده کرد.



شکل ۶ - ساختار نوار که نشان دهنده تراز واقع در وسط شکاف انرژی یک سولیتون و انتقال بین نواری ($\hbar\omega_1$) و انتقال وسط شکاف انرژی ($\hbar\omega_2$) است: (الف) سولیتون خنثی، (ب) سولیتون مثبت و (ج) سولیتون منفی [28].

ج - وجود رابطه معکوس بین اسپین و بار، یعنی وجود باردار سولیتونهای قادر اسپین که این اثر را می‌توان به طور مستقیم با استفاده از رزونانس اسپین الکترون بررسی کرد. به این ترتیب که در واقع تعداد احیینها (N_e) نسبت به تعداد بارها (N_b) خیلی کوچکتر از ۱ بوده و به صفر نزدیک است: $(\Rightarrow) 1 <> N_e/N_b$ [15, 16].

باشند و همان طور که در بالا اشاره شد، جفت سولیتون متصل به هم می‌تواند پلارون یا بی‌پلارون تلقی شود. این حبس شدگی سبب می‌شود که بی‌پلارونها به عنوان کم‌انرژی ترین آرایش انتقال بار در چنین زنجیرهایی به حساب آیند. انرژی تولید بی‌پلارونها اندکی بیش از $\frac{4\pi}{5}$ است (با میل کردن این حبس شدگی به سمت صفر، انرژی تولید آنها به $\frac{4\pi}{5}$ می‌رسد). نمودار سطوح انرژی برای یک بی‌پلارون مثبت در شکل ۸ ارائه شده است. دو تراز موجود در شکاف انرژی، در بی‌پلارون مثبت خالی (بار $+e$) و در بی‌پلارون منفی برزند (بار $-e$) [18].



شکل ۸ - ساختار نوار بی‌پلارونها و پلارونها و ترازهای وسط شکاف انرژی و نحوه برآوردن آنها: (الف) بی‌پلارون که ترازهای شکاف انرژی، انتقال بین نواری (VR) و انتقالهای فرعی (ΔE ، $\hbar\omega_0$ و $\hbar\omega_0 + \hbar\epsilon$) شان داده شده‌اند. (ب) پلارون که ترازها به طور جزئی برآورده‌اند (به عنوان مثال، الکترون در تراز پایین در پلارون مثبت وجود دارد که باعث به وجود آمدن سوین جذب فرعی پس از ایجاد پلارون می‌شود) [8].

محاسبات شیمی کوانتومی، در مورد ساختار الکترونی بی‌پلارونها در برخی سیستم‌های پلیمری مانند پلی‌بارافنیلن، پلی پیرول و پلی تیوفن به انجام رسیده است [20]. نتایج این محاسبات طرحی از منبع به وجود آمدن بی‌پلارونها را نشان می‌دهند. از آنجا که با خارج شدن بار از حلقه سترنی، حالت کینون مانند (quinoid) برحالت بنزن مانند (آروماتیک) ترجیح دارد، بنابراین می‌توان بی‌پلارون را همانند یک قسمت کینون مانند در نظر گرفت که در اثر انتقال بار به طور فضایی در قسمتی از زنجیر به وجود می‌آید (شکل ۹ - الف).

چنین حالتی را می‌توان برای پلی تیوفن نیز در نظر گرفت (شکل ۹ - ب). اگر تاجوراتم گوگرد در پلی تیوفن کنار گذاشته شود، آن گاه ساختار یک زنجیر پلی اینی می‌ماند که از قطعاتی دارای چهار اتم کربن با هیبرید شدن P^3S تشکیل شده است. در این ساختار همگی آنها ترانس بوده و از طریق واحدهای سیس به هم متصل شده‌اند.

در چنین ساختاری دو حالت پایه غیر هم انرژی می‌باشند (شکل ۱۰). با وجود این، انتظار می‌رود که مقدار $\Delta E/d$ برای آن کوچک باشد یا به عبارت دیگر مقداری بزرگتر از صفر داشته و لیکن مقدار $\Delta E/d$ برای سیس - $(CH)_n$ نزدیک باشد. پلارونها می‌توانند به عنوان برانگیختگی‌های معتبر،

جذب شدید و پهن در 900 cm^{-1} ، به نام گونه صفر گلدستون (Goldstone) خوانده می‌شوند. تابعه جذبی آن، به علت ثابت شدن سولیتونهای پاردار در اثر نیروی کولمی به یون مخالف، جا به جا شده است. پنهانی که در جذب مشاهده می‌شود به سبب غیر یکوتاختی این ثابت شدگی است. به دلیل توزع فضایی بار سولیتون (۱۹۵ $\text{nm} \approx 24\text{ }\mu\text{m}$) فرکانس ثابت شدن تا حدودی به اندازه و ساختار یون مخالف غیر حساس می‌باشد. این نظریه که گونه 900 cm^{-1} همان گونه گلدستون ثابت شده در اثر تعریک نوری به وجود آمده‌اند. در این نمونه‌ها، گونه گلدستون در حدود 500 cm^{-1} ظاهر می‌شود، زیرا در اینجا میدان کولمی ناشی از یون مخالف (دو به کننده) وجود ندارد.

از بین رفتن هم ترازی حالت‌های پایه خلاصه‌ای از نتایج نظری در مورد حالت پایه و برانگیختگیها از میان رفتن هم ترازی حالت‌های پایه، منجر به تغییرات مهم در خواص حالت پایه و برانگیختگیها می‌شود که به قرار زیر است:

- ۱ - در این حالت شکاف انرژی فقط به دلیل نابایدواری ذاتی پیرلز (Δ) به وجود نمی‌آید، بلکن مقدار Δ یا پتانسیل بلوری نکه کرون (one-electron crystal potential) نیز در آن سهیم است [18]:

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$$

۲ - سولیتونها دیگر برانگیختگی‌های مناسب سیستم نیستند و حالت‌های پایه غیر هم انرژی جفت‌های سولیتون - ضد سولیتون را به بی‌پلارونها (bipolarons) محدود می‌سازد. ولی بی‌پلارونها (polarons) می‌توانند همچنان به عنوان برانگیختگی‌های معتبر باقی بمانند. بی‌پلارونها می‌توانند جفت سولیتونهای باردار حبس شده (confined) تلقی شوند و پلارونها نیز به نوبه خود می‌توانند مانند سولیتونهای باردار متصل به سولیتونهای خنثی (از طریق حبس شدگی) به حساب آیند [30].

منبع اصلی این حبس شدگی را می‌توان به سادگی با ارائه مثالی توضیح داد [31]: ساختار سیس - پلی استیلن در شکل ۳ - الف را در نظر بگیرید. در چنین ساختاری حالت‌های پایه غیر هم انرژی می‌باشند. اختلاف انرژی بین دو حالت پایه به ازای هر پیوند ($\Delta E/d$) می‌تواند یک مقدار مشخص باشد. یک نتیجه روشن از عدم هم ترازی حالت‌های پایه این است که در چنین ساختاری برانگیختگی‌های سولیتونی آزاد و بایدار نمی‌توانند جدا از هم وجود داشته باشند، زیرا تولید یک جفت سولیتون در فاصله d از هم، مقدار انرژی $\Delta E/d$ را مصرف خواهد کرد. یعنی، سیستم در فاصله بین این دویچ خورددگی (kink) در آرایش برانرژی (high energy) خواهد بود. بنابراین، ترجیح داده می‌شود که جفت سولیتون در حداقل فاصله از یکدیگر قرار گیرند، یعنی $d = 0$ باشد که همان مفهوم حبس شدگی است. به عبارت دیگر ارجع است که جفت سولیتون به هم متصل

تولید پلارون، E_B ، توسط معادله زیر داده می‌شود:

$$E_B = \frac{1}{\pi} E_S = \frac{1}{2\pi/\delta} = \frac{1}{2}$$

به طوری که به عنوان مثال می‌توان نوشت:

$$S^+ + S^- \rightarrow P^+$$

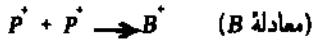
که در آن P^+ نشان‌دهنده پلارون مثبت و S^+ و S^- نشان‌دهنده سولیتون و ضد سولیتون باردار است.

در این سیستمها سطوح انرژی، شکل A – ب را خواهد داشت. در پلارونها، ترازهای شکاف انرژی به طور جزئی پر شده‌اند، به عنوان مثال در پلارون مثبت یک الکترون در تراز پایین وجود دارد که سومین جذب فرعی در شکاف انرژی را بس از تشکیل پلارون سبب می‌شود.

هنگامی که هم ترازی حالت‌های پایه از بین می‌رود، محدودیت انرژی سبب می‌شود که ترازهای انرژی به صورت ترازهای شکل A – الف درآیند. در این حالت اگر چه انرژی بی‌پلارون بیشتر از انرژی دو سولیتون است (به دلیل حبس شدگی)، ولی انرژی تولید یک جفت سولیتون حبس شده (بی‌پلارون) کمتر از انرژی تولید دو پلارون خواهد بود، یعنی خواهیم داشت [18]:

$$(نابرابری A) \quad E_B < 2E_S$$

مانند:

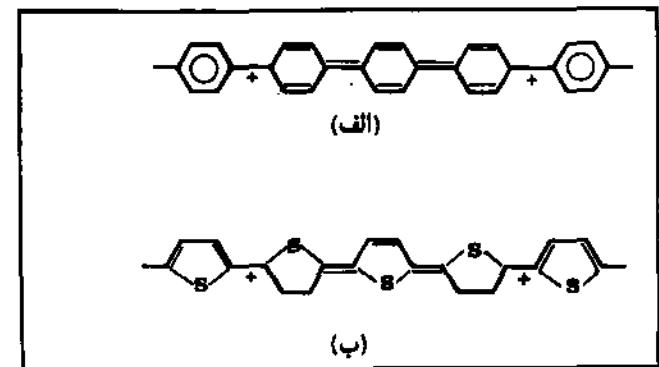


آرایش الکترونی بی‌پلارون مشابه پلارون است، با این تفاوت که ترازهای شکاف انرژی در آن کاملاً بی‌پلارون یا کاملاً خالی می‌باشند. بنابراین، بی‌پلارونها حاملینی قادر اسپین می‌باشند که بار دوگانه دارند و نقش اساسی را در پلیمرهای مزدوج با حالت‌های پایه غیر هم انرژی، به عهده می‌گیرند.

به دلیل مشکلات توبولوژیک، پرش سولیتون از یک زنجیر به زنجیر مجاور غیر ممکن است، ولی این امر برای پلارونها و بی‌پلارونها امکان‌پذیر است. بنابراین، پرش پلارون یا بی‌پلارون اهمیت خاصی در انتقال بار در سه بعد دارد.

بی‌پلارونها در بلی‌تیوفن، خلاصه‌ای از نتایج تجربی همان گونه که قبل اشاره شد از بین رفتن هم ترازی حالت‌های پایه، منجر به حبس شدن جفتهای سولیتون – ضد سولیتون به بی‌پلارونها می‌شود که دارای ترازهای انرژی نشان داده شده در شکل A – الف می‌باشند. نابرابری A و معادله مربوط به آن (معادله B) از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید بی‌پلارونها (و نه‌پلارونها) در صورتی امکان‌پذیر است که این رابطه‌ها صادق باشند. در این مورد نیز سه شاهد تجربی، دال بر ایجاد بی‌پلارونها موجود است:

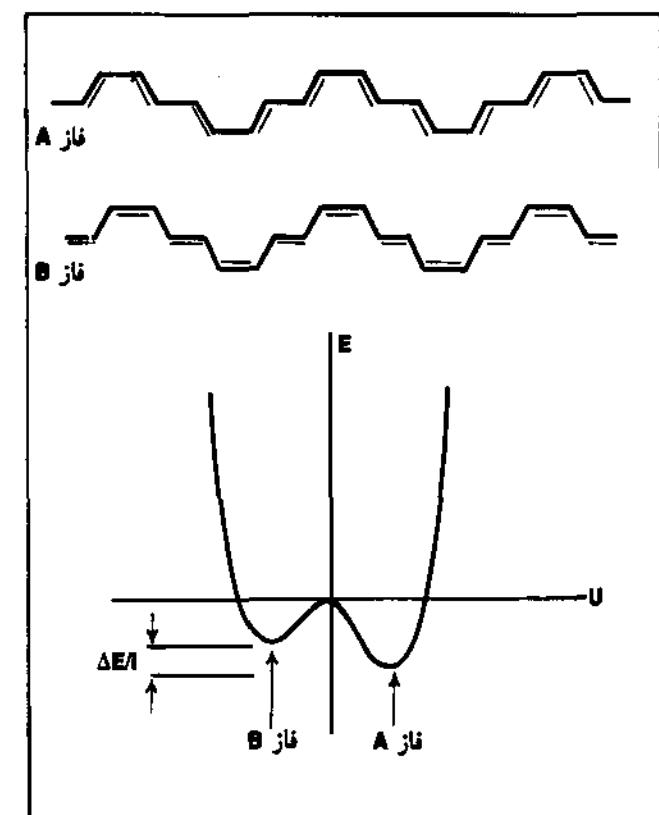
- ۱ – به وجود آمدن و ایجادگی ساختاری مستقر و گونه‌های ارتعاشی مربوط به آن (گونه‌های IRAV).



شکل ۹ – ساختار نمایشی بی‌پلارونها:
(الف) بی‌پلارون دو مثبت در زنجیر پلی (پارا-فنیلن) (ب) بی‌پلارون دو مثبت در زنجیر پلی تیوفن [20].

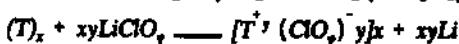
هم در سیستمهای با حالت‌های پایه هم انرژی و هم در سیستمهای با حالت‌های پایه غیر هم انرژی، وجود داشته باشد.

در شرایطی که حالت‌های پایه هم انرژی باشند، انرژی لازم برای



شکل ۱۰ – دو ساختار بیرونی از یک بلیان مشابه سیس – $(CH)_x$: فاز A – آرایش سیس – ترانس مانند و فاز B – آرایش برانرژی ترانس – سیس مانند. آرایش فاز B دارای انرژی بیشتری به ازای واحدهای CH است. شکل باعین نشان‌دهنده دو کمینه مربوط به دو آرایش غیر هم انرژی است [20].

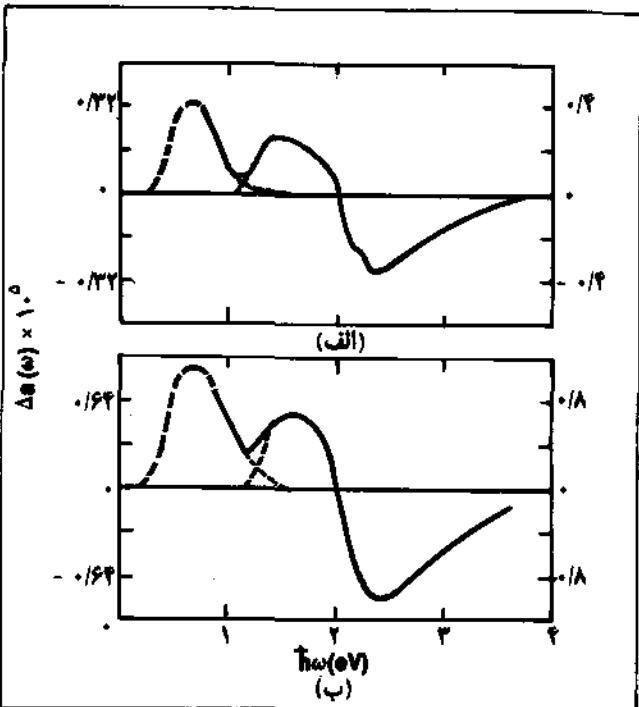
با پیشرفت چرخه واکنش دوبه کردن زیر:



شدت انتقال بین نواری به طور پیوسته کاهش می‌یابد و پیک جذبی آن به سمت انرژی‌های بالاتر جایگذاشت. علاوه بر این، دو گونه جذبی جدید در زیر این پیک ظاهر می‌شود که شدت آنها با افزایش میزان دوبه کننده افزایش می‌یابد.

همچنین پیک با انرژی بالاتر، با افزایش میزان دوبه کننده به سمت انرژی‌های بالاتر جایگذاشت. در حالی که پیک با انرژی کمتر در همان انرژی (0.065 eV) باقی می‌ماند، بررهی به دست آوردن صحت بیشتر می‌توان از طیفهای دیفرانسیل (*differential spectra*) استفاده کرد [22]. در شکل ۱۲ دو نمونه در غلظتها دوبه کننده $y = 0.04$ (یا 1% به ازای هر کربن) و $y = 0.12$ (یا 3% به ازای هر کربن) دیده می‌شود. در ناحیه IR، دو پیک در 0.065 eV و 0.085 eV به وضوح دیده می‌شود.

با بررسی شکل‌های ۱۱ و ۱۲ مشخص می‌شود که قدرت نوسانگر این پیکهای جذبی در حدود همان جذب وسط شکاف انرژی است که در پلی‌استیلن وجود داشت. بنابراین، نتیجه می‌شود که این در جذب از انتقال‌های الکترونی بین نوار الائس و دو تراز مستقر در شکاف انرژی که در اثر دوبه کردن به وجود می‌آید، ناشی می‌شود که با فرضیه باردار بودن پلی‌بلارونها نیز توافق دارند.



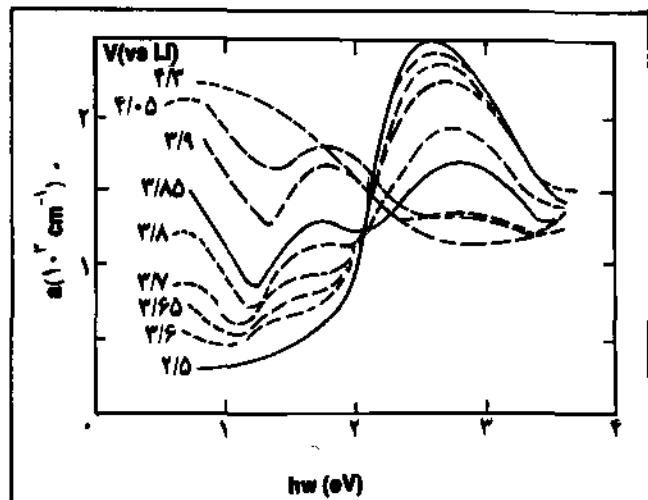
شکل ۱۲ – طیف دیفرانسیل که از شکل ۱۱ به دست آمده است: (الف) $y = 0.04$ و (ب) $y = 0.12$ [22].

علاوه بر پلی‌تیوفن، پلی (۳-متیل‌تیوفن) نیز در غلظتها باین دوبه کننده (یعنی در $y > 0.1$) مورد بررسی دقیق قرار گرفته است [23].

۲ – ایجاد ترازهای انرژی متقاضی نسبت به مرکز شکاف انرژی و انتقال‌های الکترونی مربوط به آنها (شکل ۸-ب). این انتقال‌های مخصوص پلی‌بلارون را می‌توان در زیر قرمز تزدیک مشاهده کرد.
۳ – رابطه معکوس بین بار – اسپین، یعنی باردار بودن پلی‌بلارونها فاقد اسپین. این شواهد تجربی در مورد پلی‌تیوفن دوبه شده و تحریک شده نوری بررسی شده است [21].

پلی‌بلارونها (و پلی‌بلارونها) در پلی‌تیوفن، دوبه هین با انتقال بال کونهای ارتعاشی فعال در IR: نخستین آزمایش‌های دوبه شدن چهارگونه IRAV اصلی را به ترتیب در 1120 , 1020 , 1200 و 1322 cm^{-1} و همچنین گونهای ضعیفتری در 680 , 640 و 570 cm^{-1} نشان داده است [33]. همانند پلی‌استیلن، مقایسه گونهای IRAV که در اثر دوبه کردن به وجود می‌آیند با آنها که در اثر تحریک نوری ایجاد می‌شوند اهمیت ویژه‌ای دارد. دوباره مشاهده شده که وجود گونهای IRAV دلیلی برای وجود آمدن واپسی‌گذگی ساختاری در اطراف آرایش‌های باردار در پلی‌تیوفن می‌باشد.

ترازهای متقاضی در شکاف انرژی و انتقال‌های الکترونی مربوط به آنها: شکل ۱۱ مجموعه‌ای از طیفهای جذبی به دست آمده هین دوبه کردن الکتروشیمیایی را نشان می‌دهد [22].



شکل ۱۱ – منحنیهای جذبی هین دوبه کردن الکتروشیمیایی پلی‌تیوفن با ClO_4^- و تراز اعمال شده نسبت به Li^+ ($V_{\text{vs Li}}$) در سمت جب منحنیها نوشته شده است و غلظتها معادل دوبه کننده (برحسب درصد مولی به ازای حلقه تیوفن) به قرار زیر است:

$2/18.0\text{V}$, ($y = 0.028$) $2/10.6\text{V}$, ($y = 0.054$) $2/17.0\text{V}$, ($y = 0.084$) $2/16.5\text{V}$, ($y = 0.114$) $2/19.0\text{V}$, ($y = 0.140$) $2/18.5\text{V}$, ($y = 0.166$) [22].

سلول (یا پتانسیل شبیه‌یاری، $\Delta\mu$) اندازه‌گیری می‌شود. در حوالی نقطه خنثی، یک علامت ESR ضعیف در $emu/mole^{10}$ مشاهده می‌شود. این مقدار معادل یک اسپین به ازای 10^{-7} کربن در استخوان‌بندی پلیمر با کوچکتر از $2/25 mole$ در صد به ازای هر حلقه تیوفن است. اگر ولناز سلول برای چندین روز در $7/25$ نسبت نگه داشته شود، این مقدار به آستنگی کاهش می‌یابد. با انجام عمل دوبه کردن در حدود $7/3$ نسبت به $7/1$ ، یک پیشینه در مغناطیس پذیری مشاهده می‌شود که حلوود $emu/mole^{10}$ می‌باشد. در بالاتر از $7/27$ نسبت به $7/1$ ، مغناطیس پذیری تا کمتر از $5\times 10^{-8} emu/mole^{10}$ کاهش می‌یابد. و سرانجام نتیجه حاصل این است که بی‌پلارونها به وجود آمده قادر اسپین می‌باشند.

بی‌پلارونها و پلارونها در پلی‌تیوفن، تحریک نوری تولید مستقیم بی‌پلارونها برداران از راه تحریک سوری بدون شک غیرممکن است. پس از ایجاد حفره – الکترون از طرق تحریک نوری، محدودیت ناشی از یکسان نبودن انرژی حالت‌های پایه سبب تشکیل سریع بی‌پلارونها خنثی می‌شود، یعنی یک برانگیختگی خنثی با ترازهای شکل $7/1$ که یک الکترون در تراز بالایی و یک الکترون در تراز پایین دارد. انتظار می‌رود که این بی‌پلارونها خنثی، به سرعت دچار تجزیه شوام با نشر نور شوند که مشاهده لومینسانس سریع، $7/1$ ، درست در زیر شکاف انرژی $1/9$ (۱۹) این مکانیسم را تأیید می‌کند.

نتیجه‌گیری

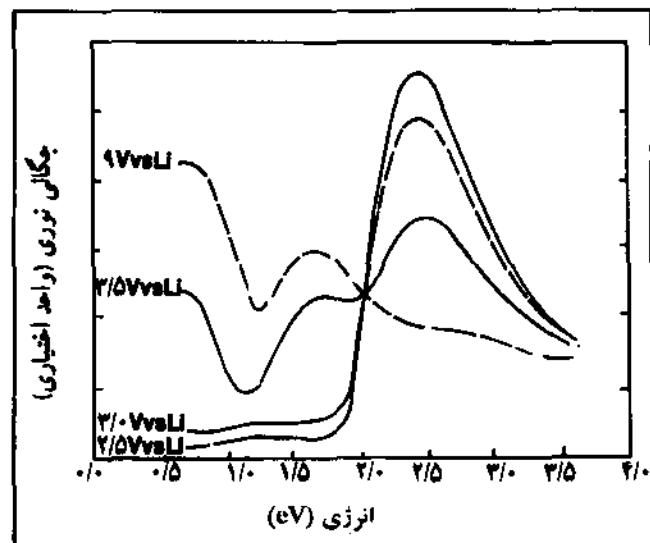
پلیمرهای رسانا پلیمرهای هستند که در استخوان‌بندی آنها سیستم الکترونی Π مزدوج طویل وجود دارد که پلی‌استیلن و پلی‌تیوفن در نمونه از آنها می‌باشند.

این پلیمرها برخی دو حالت پایه هم انرژی (مانند پلی‌استیلن) و بعضی دو حالت پایه غیر هم انرژی (تیوفن) دارند. رسانندگی این پلیمرها را می‌توان در اثر دوبه کردن افزایش داد. عمل دوبه کردن باعث اکساشیون کاهش استخوان‌بندی پلیمر می‌شود یا به عبارتی پلیمر دارای بار مثبت یا منفی می‌شود و برای خنثی شدن بار الکتریکی یک یون مخالف به درون زنجیرهای پلیمر نفوذ می‌کند. بارهای ایجاد شده در پلیمر در یک آرایش ساختاری در گسترش پیوندهای Π مزدوج جای می‌گیرند. این آرایش ساختاری به عنوان یک برانگیختگی در الکtron‌های Π تلقی می‌شود که دارای بهنا، جرم جنبشی و انرژی ویژه می‌باشد. هرگاه دو حالت پایه پلیمر هم انرژی باشند، این آرایش یک سولیتون است. پنهانی سولیتون (۲۶) معادل $12/4$ (۱۲) تصویر فاصله دو کربن مجاور در امتداد زنجیر است) و جرم جنبشی آن حدود 6 برابر جرم الکترون است. انرژی تولید سولیتون اندکی کمتر از نصف شکاف انرژی است. سولیتونها در ساختار نوار پلیمر یک تراز در وسط شکاف انرژی دارند که می‌تواند با صفر، 1 یا 2 الکترون اشغال شود. هرگاه هیچ الکترونی در این تراز نباشد، سولیتون بار مثبت

در این بررسی اثری از سومین یک جذبی مشاهده می‌شود که حاکی از تولید پلارون (شکل ۸) در این غلظتها می‌باشد است. با افزایش غلظت دوبه کننده، تولید پلارونها به تولید بی‌پلارونها می‌انجامد. به عبارت دیگر، در غلظتها می‌باشد، هم نایبرابر A نادرست است و هم مانع برای انجام معادله B وجود دارد که شاید به دلیل بی‌نظمی و محدود بودن طول زنجیر و... باشد.

باید به خاطر داشت که تزریق یک بار منفرد به زنجیر باید از راه ایجاد یک پلارون صورت گیرد و بی‌پلارونها می‌توانند از معادله B به وجود آیند. بنابراین، حتی اگر نایبرابر A برقرار باشد (با هنگامی که صورت تساوی آن صادق باشد)، در غلظتها خلی بایین، به ویژه در نمونه‌هایی که بی‌نظمی زیاد است و نمونه‌ای که جرم مولکولی پایین دارد (تعداد حلقه‌های تیوفن در هر زنجیر کمتر از $7/1$ است)، می‌توان انتظار پلارونها را داشت (۲۴).

طیف جذبی پلی (۳- متیل تیوفن) که در حین عمل دوبه کردن الکترون‌سیمیابی به دست آمده است [۲۳] در شکل 13 دیده می‌شود. طیف پلیمر خنثی (در $2/25$ ولت نسبت به $7/1$) شکاف انرژی در حدود $2/17$ به دست می‌دهد که تقریباً برابر شکاف انرژی پلی‌تیوفن است. در مقطع بالای دوبه کردن (بالاتر از 3 ولت نسبت به $7/1$)، دو جذب فرعی در شکاف انرژی مشاهده می‌شود که یکی در حدود $5/6$ و دیگری در حدود $1/5$ قرار دارد. همچنین در مقطع دوبه کردن زیر 2 ولت، یک گونه ضعیف در نزدیکی $1/2$ ظاهر می‌شود. طیف دیفرانسیل اطلاعات اخیر را برای این سیستم تأیید می‌کند (۲۵).



شکل ۱۳ - طیف جذبی پلی (۳- متیل تیوفن) به دست آمده حین دوبه کردن الکترون‌سیمیابی [۲۳].

برای بررسی اینکه گونه‌های به وجود آمده در اثر دوبه کردن اسپین دارند یا نه، اندازه‌گیری ESR حین عمل دوبه کردن به کار گرفته شده است [۲۱]. در این آزمایشها، مغناطیس پذیری (χ) نسبت به ولتاژ

- [7] Formmer, J.E., and Chance, R.R., *Encyclopedia of Polymer Science and Engineering* (Wiley, New York), Vol 5, P 462, 1986.
- [8] Feldblum, A., Kaufman, J.H., Etemad, S., Heeger, A.J., Chung, T.C. and Mac Diarmid, A.G., *Phys. Rev. B*, 26, 815, 1982.
- [9] Chiang, C.K., Gan, S.C., Fincher, C.R., Park, Y.W., Mac Diarmid, A.G., Heeger, A.J., *Appl. Phys. Lett.*, 33, 18, 1978.
- [10] Chiang, C.K., Park, Y.W., Heeger, A.J., Shirakawa, H., Louis, E.J. and Mac Diarmid, A.G., *J. Chem. Phys.*, 69, 5098, 1978.
- [11] Mac Diarmid, A. G. and Kaner, C., *Hand book of Conducting Polymers*, Edited by Skotheim, T.A., (Dekker, New York/Basel), Vol. 1, P. 689, 1986.
- [12] Fincher, C.R., Chen, C.E., Heeger, A.J., Mac Diarmid, A.G., *Phys. Rev. B* 19, 4140, 1979.
- [13] Shirakawa, H. and Ikeda, S., *Synth. Met.* 1, 175, 1979/1980.
- [14] Weinberger, B.R., Ehrenfreund, E., Heeger, A. J. and Mac Diarmid, A. G., *J. Chem. Phys.* 72, 4749, 1980.
- [15] Flood, J.D., Chung, T.C., Moraes, F., and Heeger, A. J., *Phys. Rev. B* 19, 2341, 1984.
- [16] Chen, J., Chung, T.C., Moraes, F. and Heeger, A.J., *Solid State, Commun.* 53, 757, 1985.
- [17] Etemad, S.A. Pron, Heeger, A. J., Mac Diarmid, A.G., Mele, E.J. and Rice, M.J., *Phys. Rev. B* 23, 5137, 1981.
- [18] Brazovskii, S. A. and Kirova, N., *Dis'mazh, Eksp. Teor. Fiz.* 33, 6 [JETP Lett., 33, 4 (1981)].
- [19] Heeger, A.J., *Comments Solid State Phys.*, 10, 53, 1981.
- [20] Bredas, J.L., Chance, R.R. and Silbey, R., 1981a, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* 79, 319.
- [21] Chen, J. and Heeger, A.J., *Solid State Commun.*, 58, 251, 1986.
- [22] Chung, T.C., Kaufman, J.H., Heeger, A.J. and Wudl, F. *Phys. Rev. B* 30, 702, 1983.
- [23] Harbecke, G., Meier, E., Kobel, W., Egli, M., Kiess, H. and Tassahi, E., *Solid State Commun.*, 55, 419, 1985.
- [24] Colaneri, N., Nowak, M., Spiegel, D., Hotta, S. and Heeger, A.J., *Phys. Rev., B* 36, 7964, 1987.
- [25] Chung, T. C., Feldblum, A., Heeger, A.J. and Mac Diarmid, A. G., *J. Chem. Phys.*, 74, 5504, 1981.
- [26] Suzuki, H., Ozaaki, M., Etemad, S., Heeger, A. J. and Mac Diarmid, A. G., *Phys. Rev. Lett.*, 45, 1209, 1980.

و اسپین صفر دارد. اگر این تراز با یک الکترون اشغال شود، دارای بار خنثی و اسپین $\frac{1}{2}$ و هرگاه با دو الکترون پر شود، دارای بار منفی و اسپین صفر است. سولیتونها به دلیل دارا بودن خاصیت تسویلوزیک تنها می‌توانند به صورت جفتی تولید شوند یا از بین بروند. به عبارت دیگر، ایجاد یک سولیتون همراه با ایجاد یک ضدسولیتون است.

در پلیمرهایی که دو حالت پایه آنها غیر هم انرژی است (تبیوفن) آرایشهای باردار پلارونها یا بی‌پلارونها می‌باشند. پلارون‌های سولیتون خنثی و یک سولیتون باردار چسبیده بهم و بی‌پلارون مانند دو سولیتون باردار چسبیده به هم است. در اصل نابرابری انرژی‌های حالت‌های پایه باعث به هم چسبیدن سولیتون و ضدسولیتون به یکدیگر می‌شود. پلارونها و بی‌پلارونها هر یک دو تراز در شکاف انرژی دارند، با این تفاوت که در بی‌پلارونها، ترازها کاملاً بر (بی‌پلارون دو منفی) یا کاملاً خالی (بی‌پلارون دو مثبت) می‌باشند ولی در پلارونها ترازها به طور جزئی پرشده‌اند. ترازهای انرژی پلارونها و بی‌پلارونها نسبت به وسط انرژی متقاضانند.

سولیتونها، پلارونها، بی‌پلارونها و همجنین ترازهای انرژی هر کدام را می‌توان با استفاده از ایزارهای گوناگون شناسایی کرد. از آنجا که هر کدام از آنها به عنوان نقصی در گسترش الکترونها Π می‌باشد، انرژی‌های بر طیف IR پلیمر دارند، بدین ترتیب که هر یک از آرایشهای سولیتون، پلارون و بی‌پلارون اثر بخصوصی بر طیف IR نموده می‌گذارد. همجنین با استفاده از طیف‌نگاری الکترونی می‌توان سطح انرژی ترازهای مربوط به هر یک از گونهای فوق را به دست آورد. در موقعی که الکترون منفرد در ترازها وجود دارد (مانند سولیتون خنثی و پلارونها) می‌توان از روش‌های ESR و ENDOR برای بررسی بهنای گسونهای و جرم جنبشی آنها استفاده کرد.

از نظر انرژی تولیدی، انرژی تولید پلارونها کمتر از سولیتونها و بی‌پلارونهاست، ولی یک پلارون تنها می‌تواند به صورت منفرد بایدار باشد و در حضور پلارون دیگر نایابدار است. هر گاه دو حالت پایه پلیمر هم انرژی باشد، دو پلارون تبدیل به یک جفت سولیتون و ضدسولیتون می‌شود، ولی اگر حالت‌های پایه پلیمر غیر هم انرژی باشند، دو پلارون تبدیل به یک بی‌پلارون خواهد شد.



- [1] Peierls, R.E., *Quantum Theory of Solids* (Clarendon, Oxford), 1955.
- [2] Longuet, Higgins, H.C., and L. Salem, *Proc. R. Soc. London Ser. A*, 251, 172, 1959.
- [3] Rice, M.J. *Phys. Lett.*, 71, 152, 1979.
- [4] Zobusky, N.J., and M.D. Kruskal, *Phys. Rev. Lett.*, 15, 240, 1965.
- [5] Jackiw, R. and Rebbi, C., *Phys. Re. D13*, 3398, 1976.
- [6] Edwards, J.H. and Feast, W. J., *Polymer*, 21, 595, 1980.